

ALPS

ASIC de Lecture Pour SiPM

Fatima Mehrez

Réunion service électronique

10/04/2014

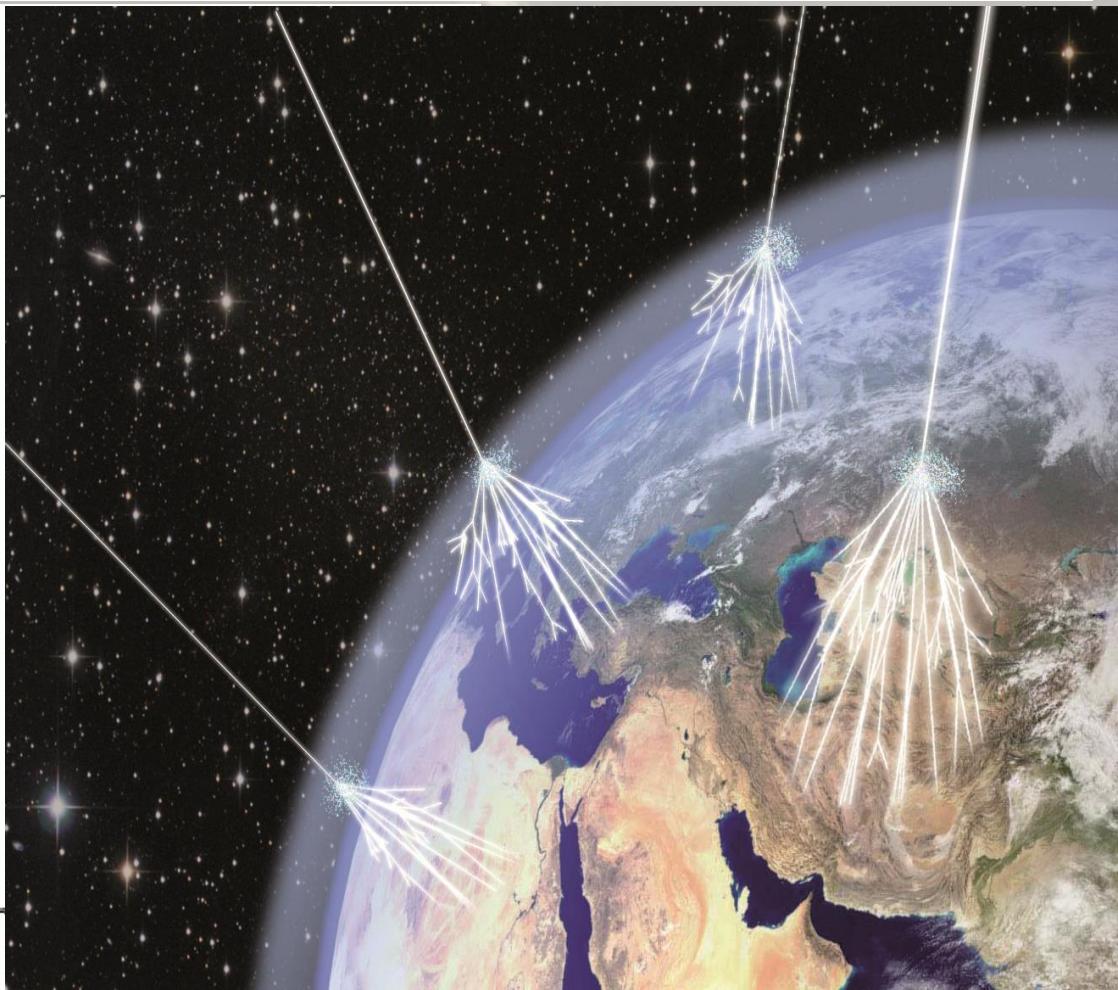
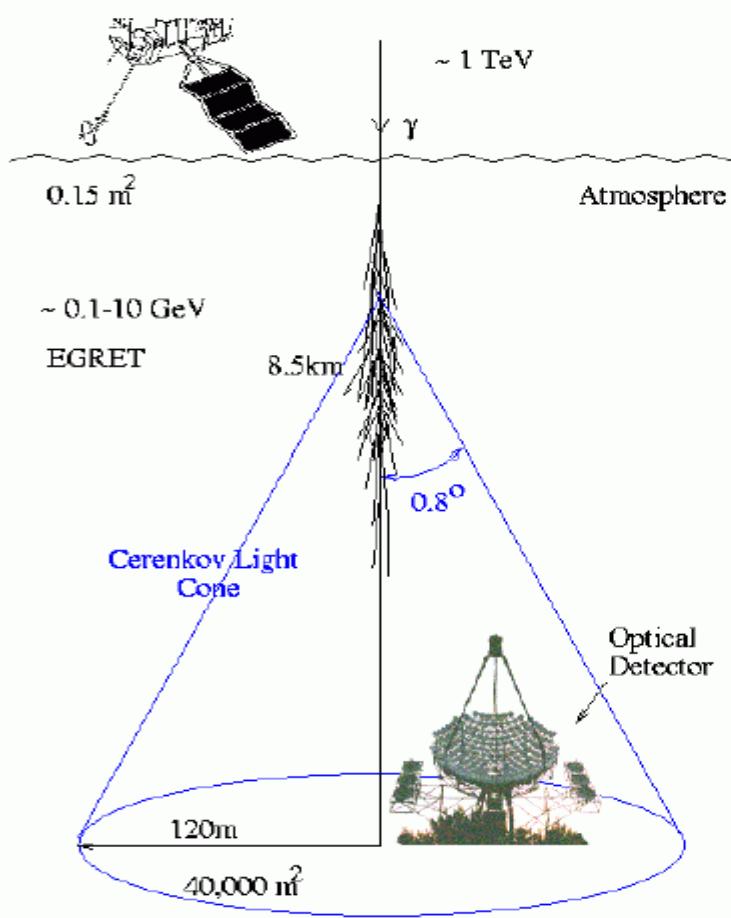
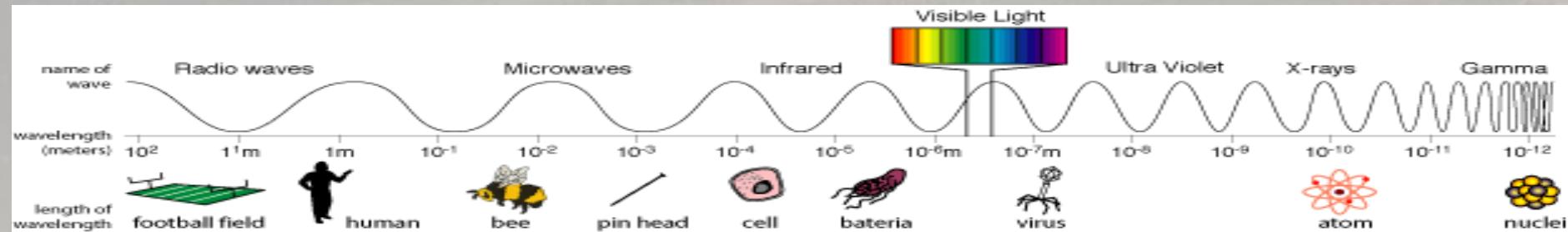
Sommaire

1. Détection de Rayon gamma par CTA
 1. Motivation
 2. Techniques de détection
 3. Structure de CTA
2. Photo détection
 1. Principe
 2. PM vs SiPM
3. Caracterisation de SiPM
 1. Banc de test
 2. Hamamatsu 4x4 matrice SiPM
 3. Analyse
 4. Electronique de lecture – cahier des charges
4. ALPS
 1. Diagram
 2. Préampli
 3. Somme analogique et ajustement des gains
 4. Trigger (DAC + discri)
 5. Layout

Motivation

- Cherenkov Telescope Array (CTA)
 - Rechercher l'origine des rayons cosmiques
 - Comprendre la nature et la variété des processus d'accélération de particules autour des trous noirs
 - Etablir la nature de matière et la physique au delà du modèle standard
- Comment? Par la détection de rayons gamma sur terre!
- Pourquoi sur terre et encore Comment?

Technique de détection de rayon gamma



Structure de CTA [1]

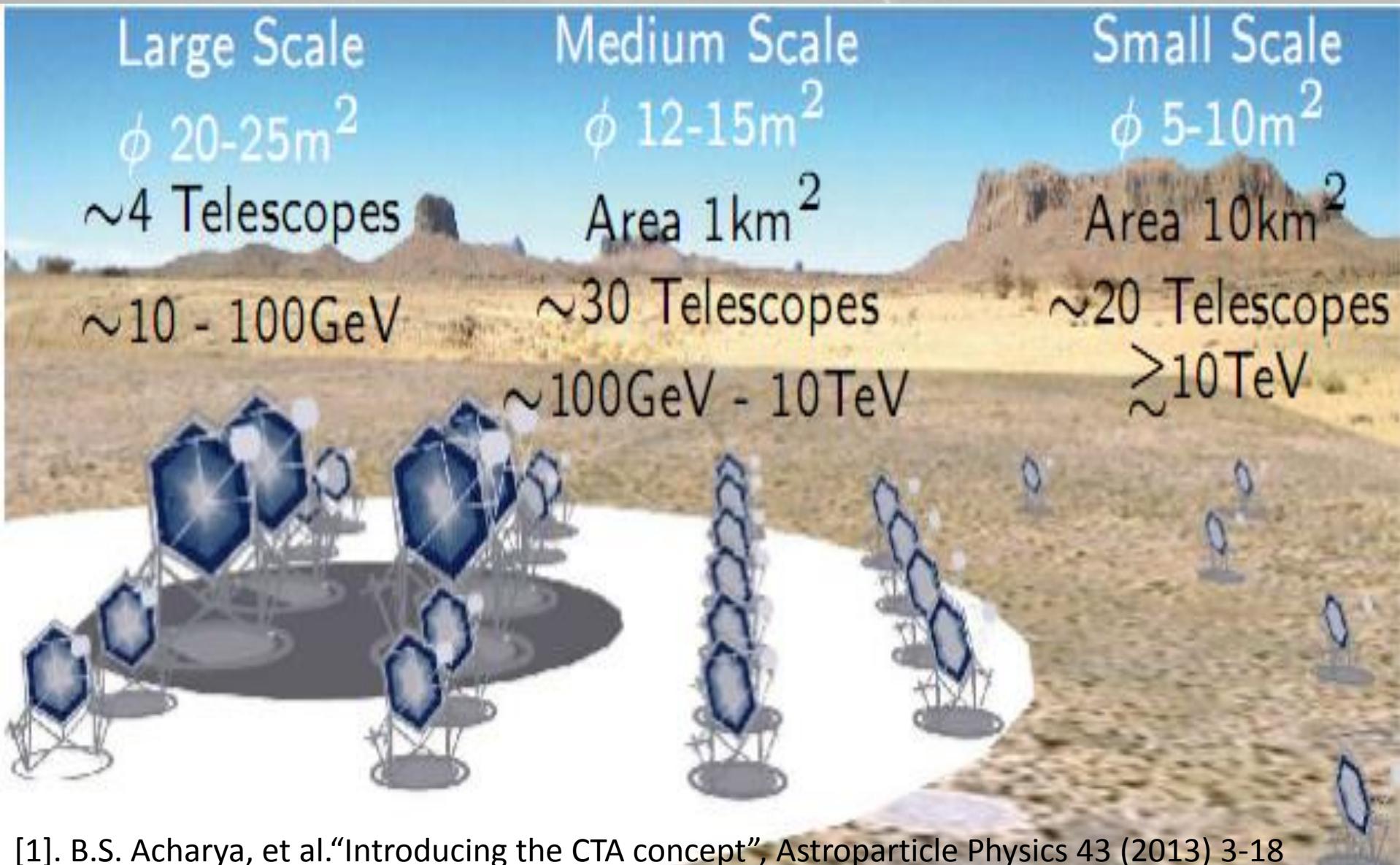
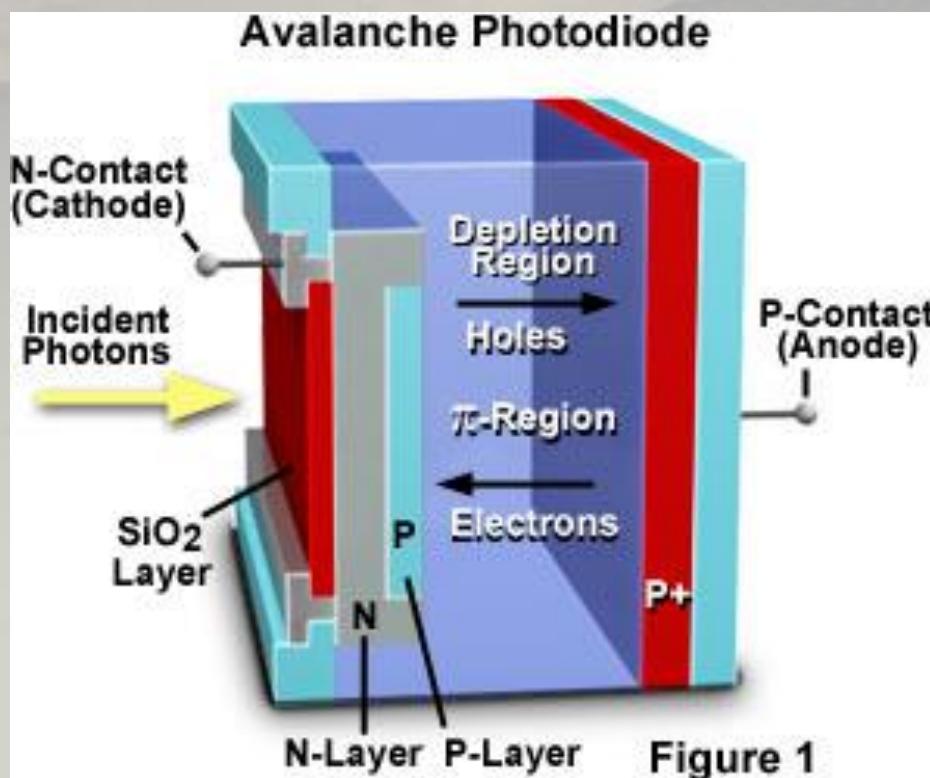
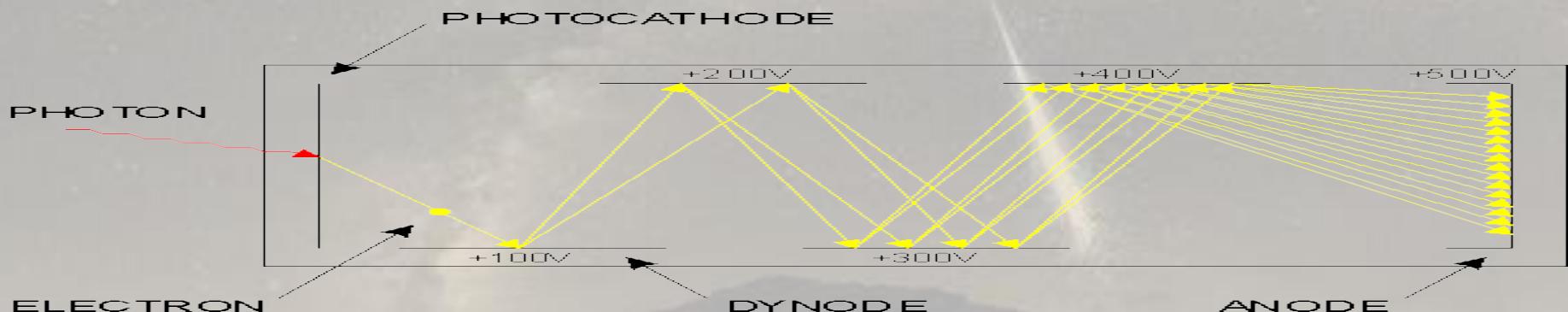


Photo détection – principe [2]



SiPM:

- matrix of n pixels (~ 1000) in parallel
- each pixel: GM-APD + $R_{\text{quenching}}$

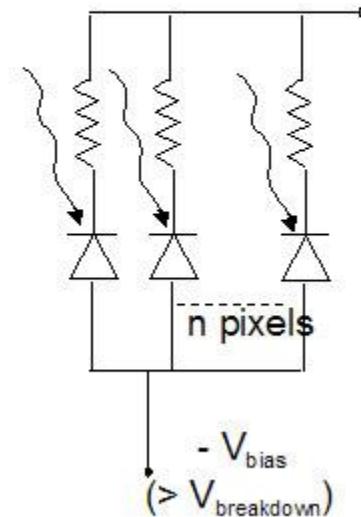
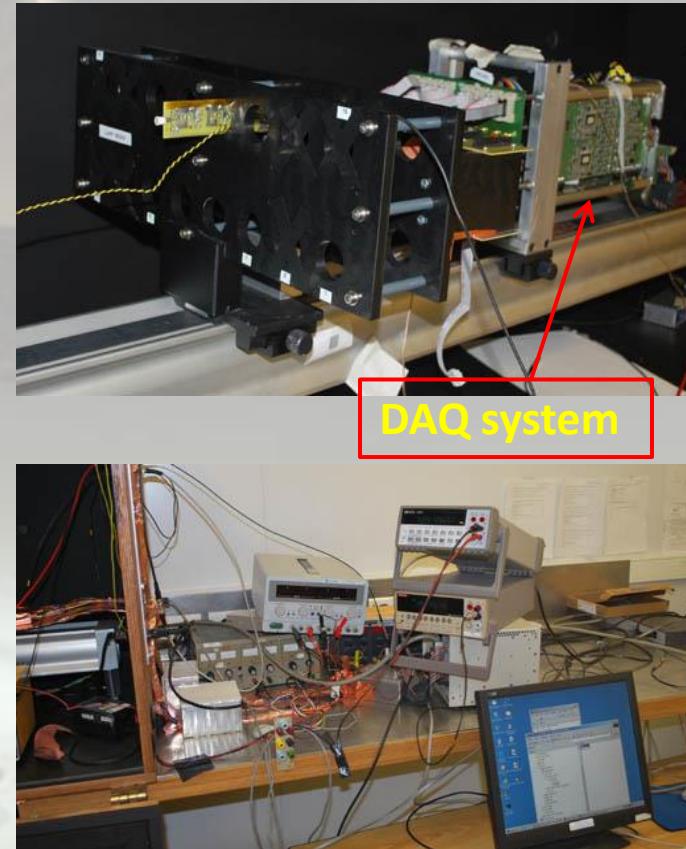
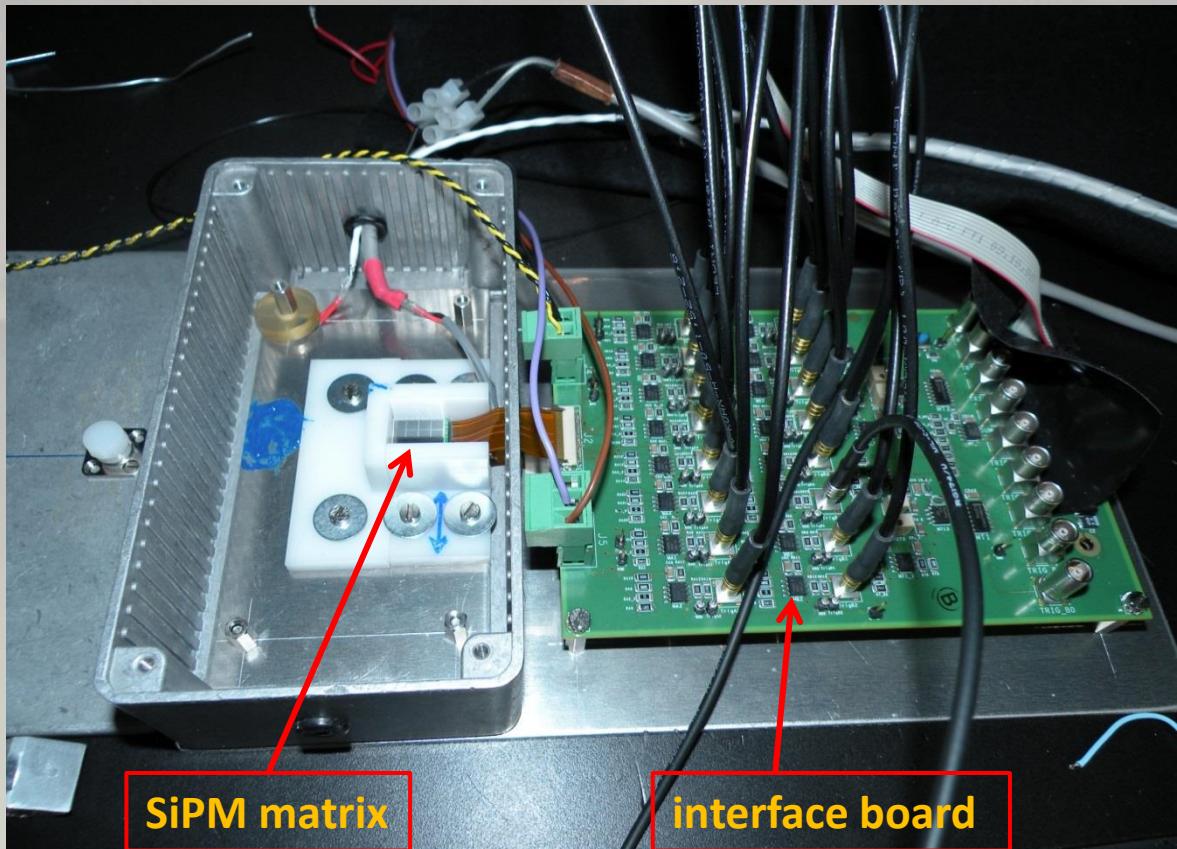


Photo détection - PMT vs SiPM

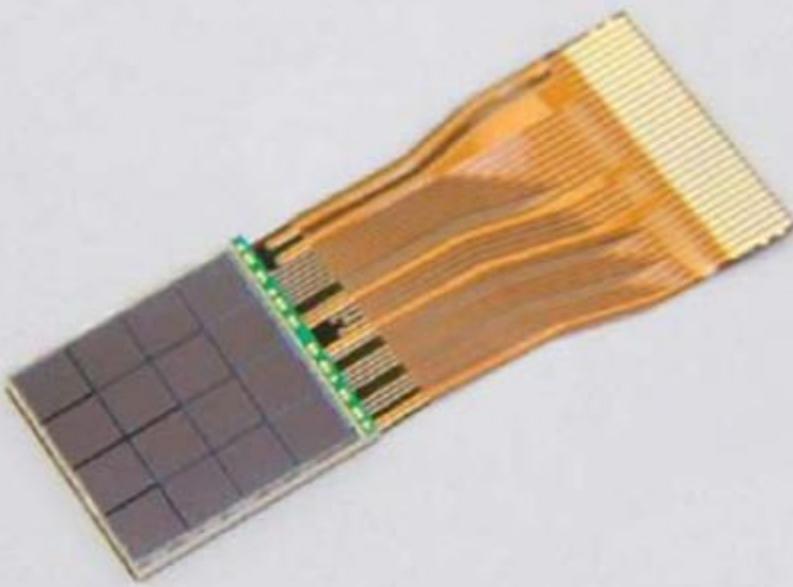
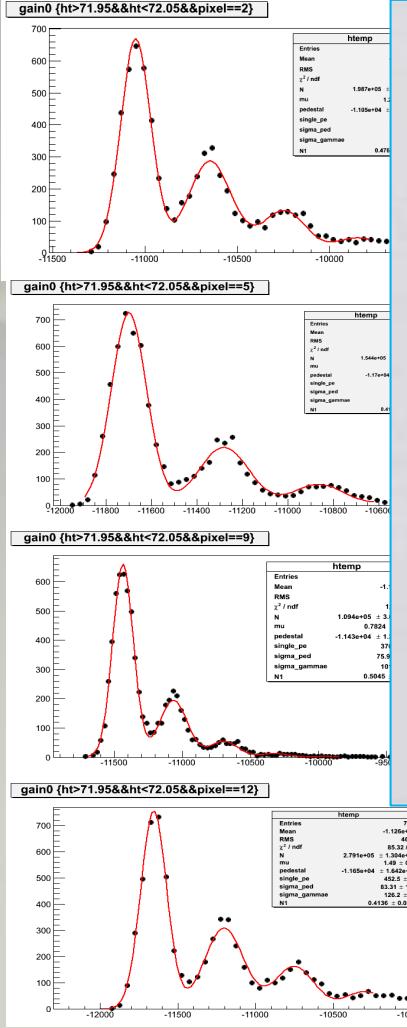
	PMT	SiPM
Sensibilité au champ magnétique et à la forte intensité lumineuse	Oui détruit	Non
Taille	volumineux	compact
Tension de polarisation	~ KV	≈ 70 V
Efficacité quantique	20 – 30 % (λ : 300-450 nm)	30 - 40 % (lumière visible)
Gain	10^6 – 10^8	~ 10^6
Bruit (Courant d'obscurité)	bas	3 μ A / canal
Crosstalk	Non	Oui

Banc de test @ LAPP – tiroir HESS II

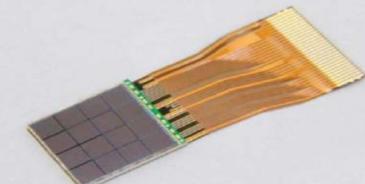
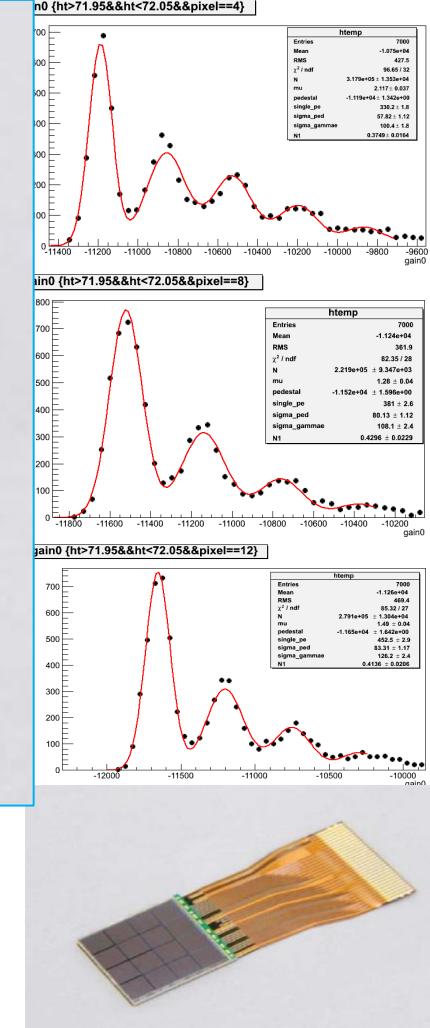


- ❖ Test with light source.
- ❖ An interface of gain stage and inversion => compatible with the HESS2 module.

Hamamatsu 4x4 matrice SiPM



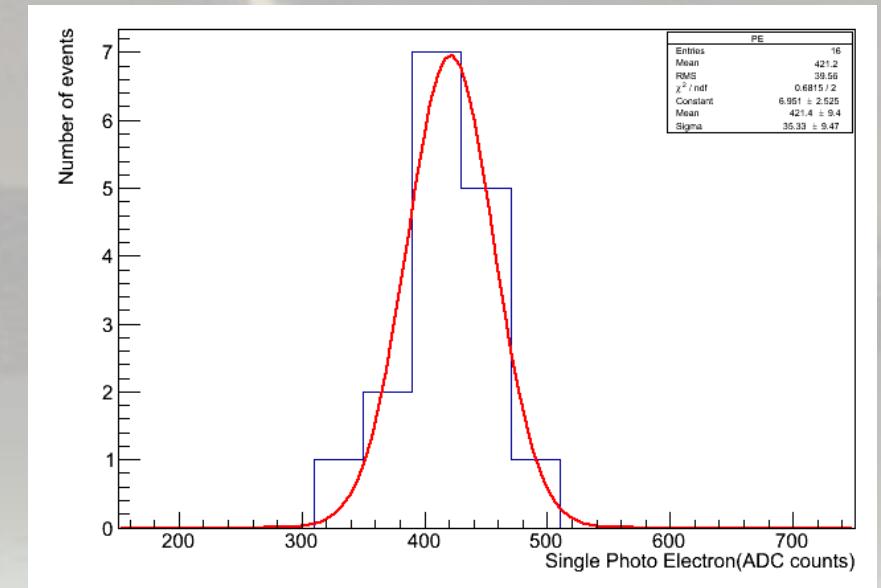
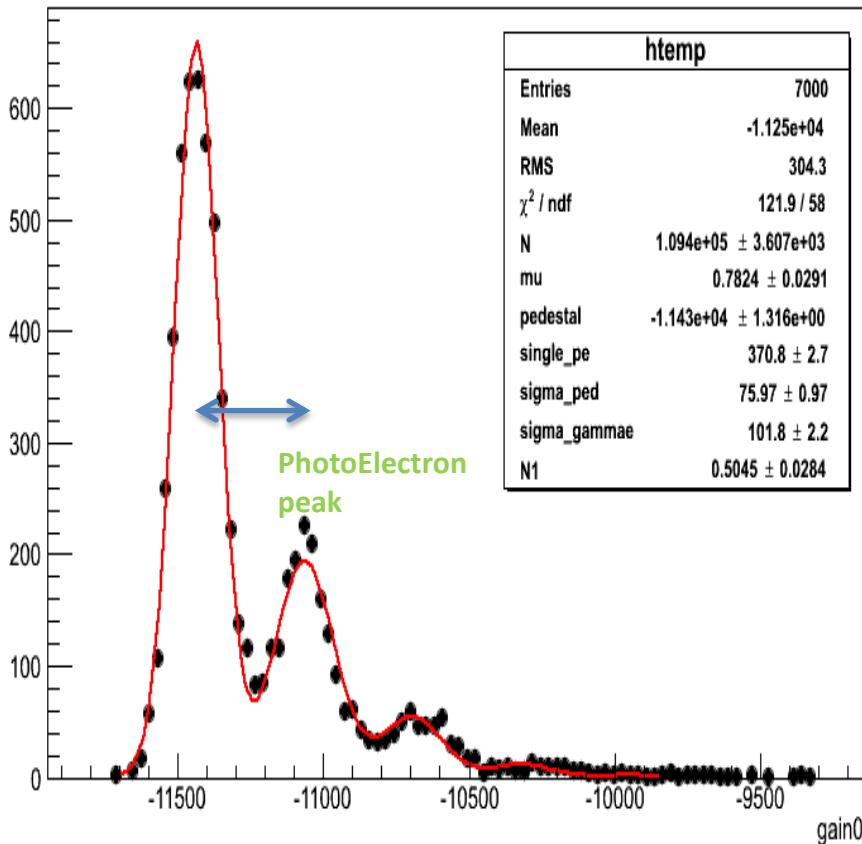
(Ref S11829-3344MF)



(Ref S11829-3344MF)

Analyse

gain0 {ht>71.95&&ht<72.05&&pixel==9}

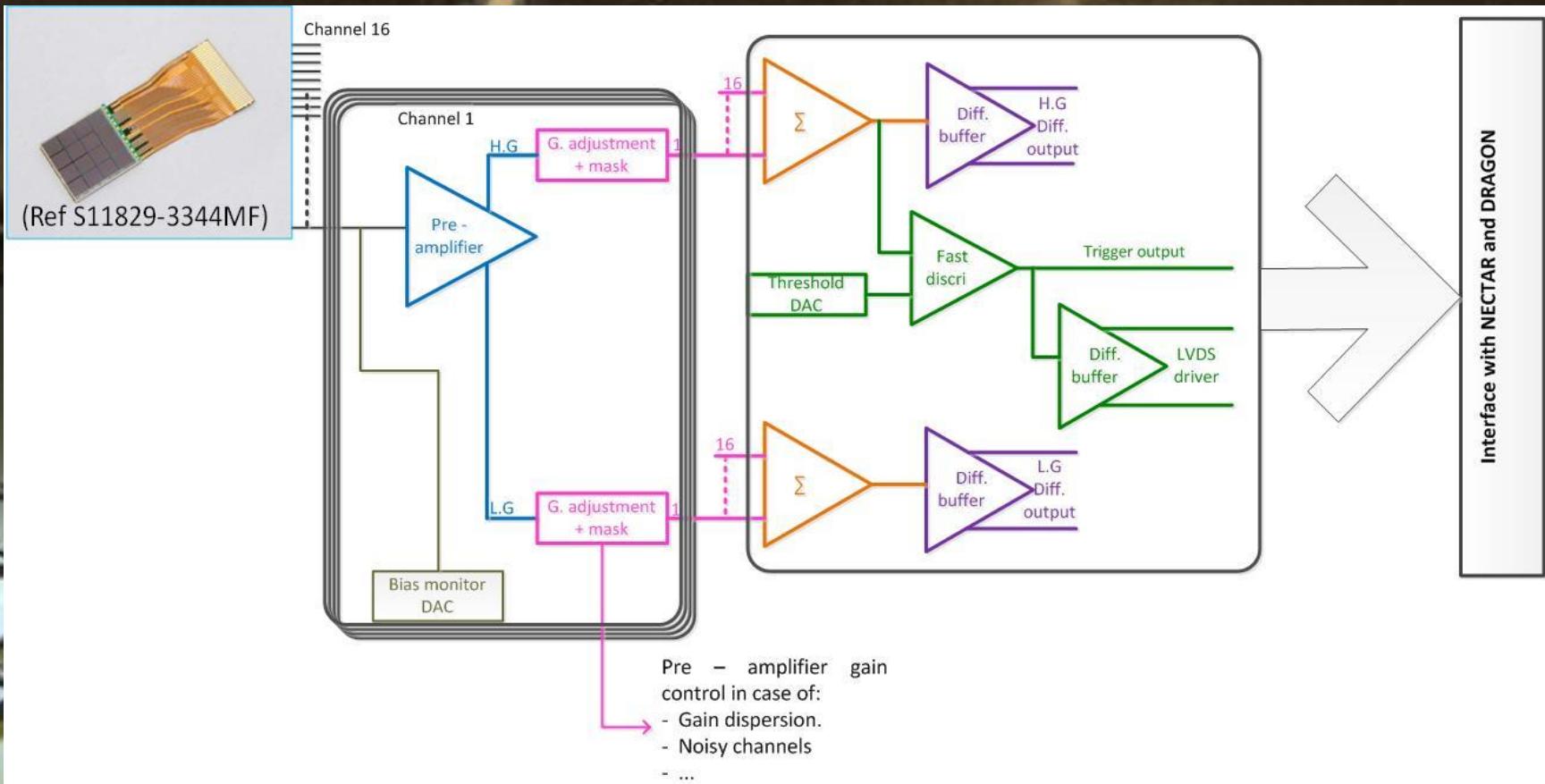


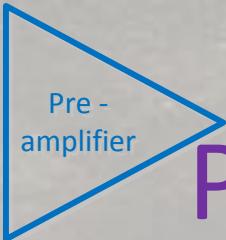
- Photoelectron ranging from : 371 to 490 (ADC counts) for **HV=72 Volts**, equivalent to a gain of **$5 \cdot 10^5$**
- **Spread ~ 10 %**
=> On-chip DAC for pixel overvoltage adjustment (performance optimization: gain and cross talk)

Electronique de lecture – cahier des charges

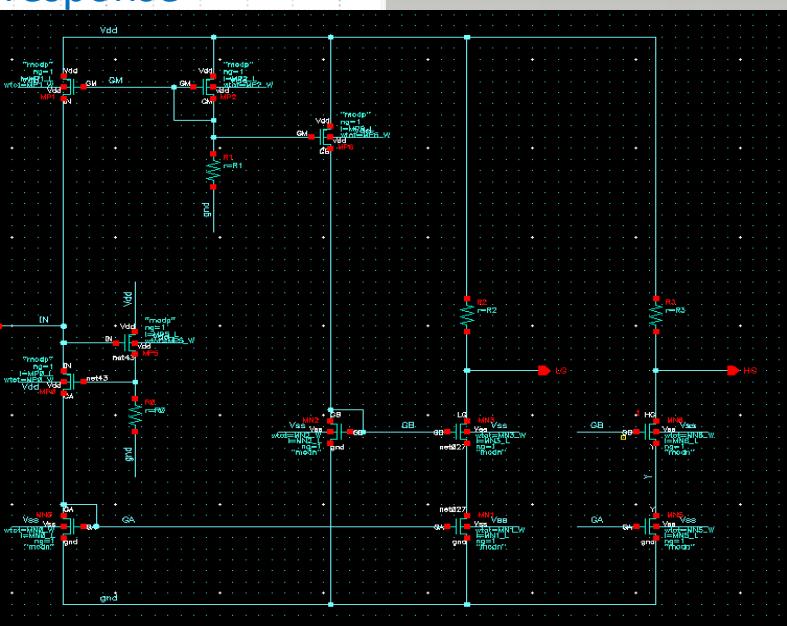
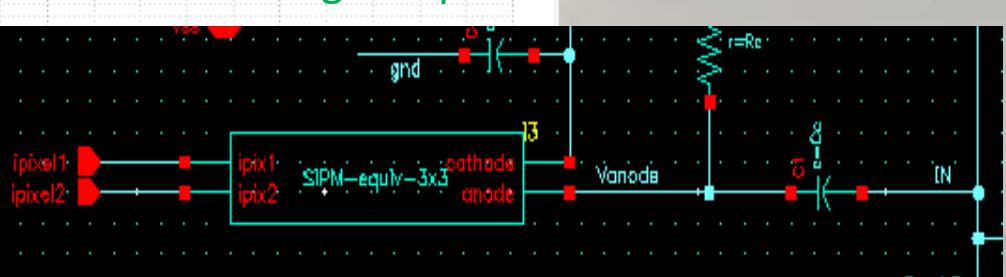
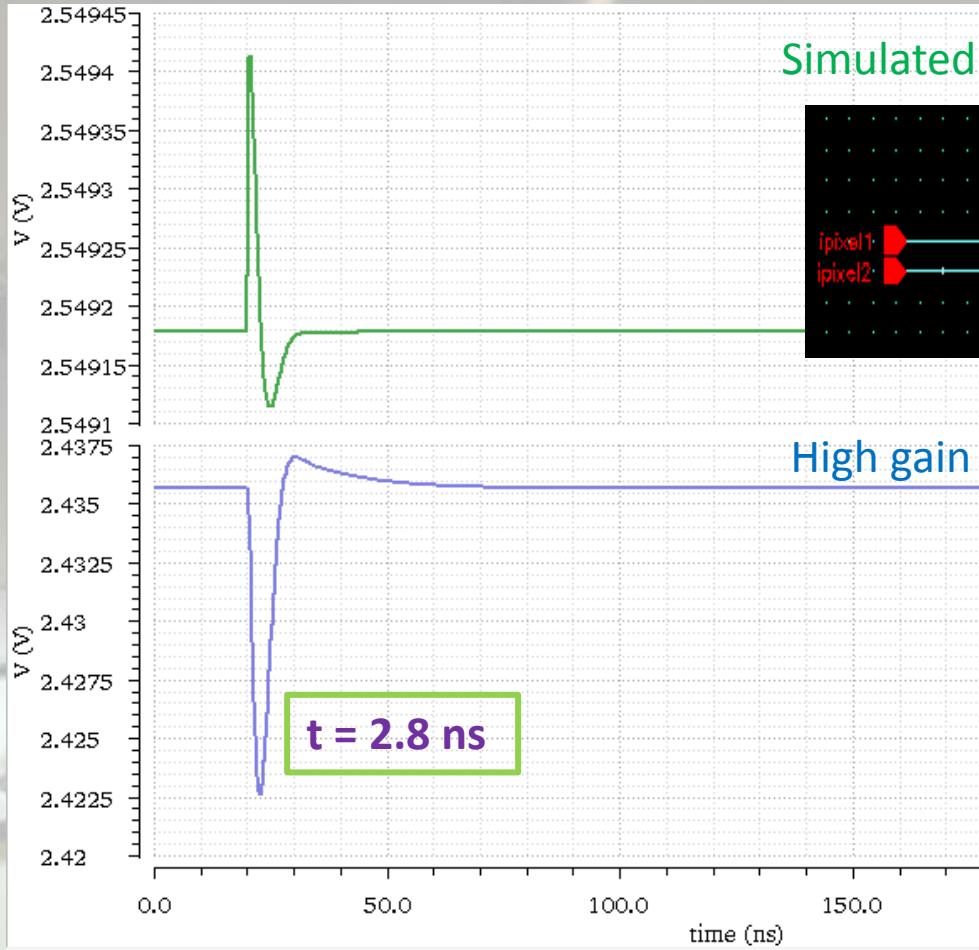
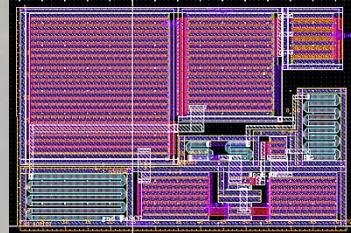
- 16 canaux de lecture par chip
 - Mesure de 1 p.e avec $S/N \geq 5$
 - Gamme dynamique de 2000 p.e. => 2 gains
 - Ajustement des gains
 - On-chip DAC - calibration de «overvoltage » par pixel
 - Somme analogique
 - Trigger :
 - Fast discriminator avec un seuil programmable
 - Interfacer avec DRAGON / NECTAR

ALPS – Diagram

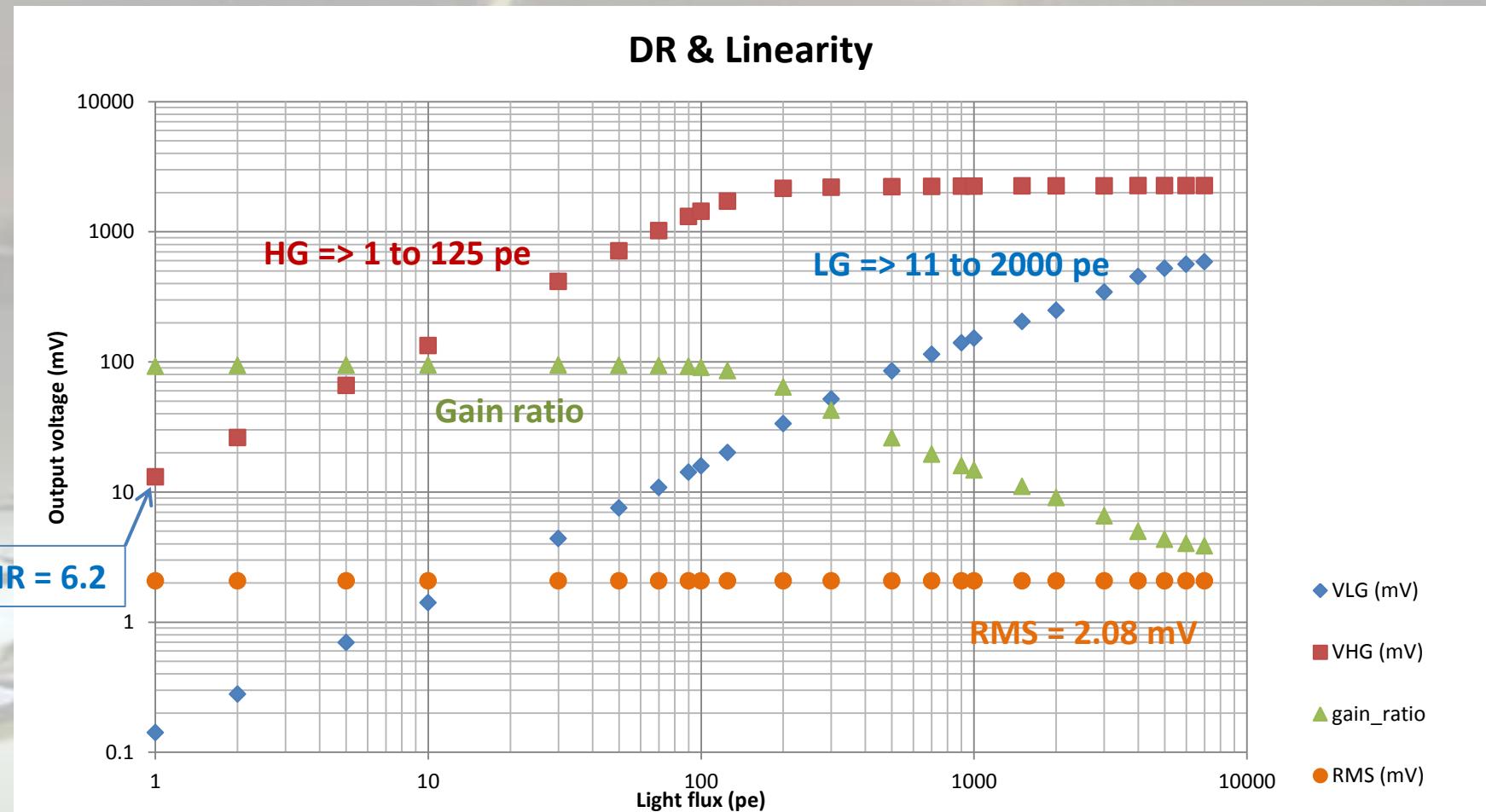




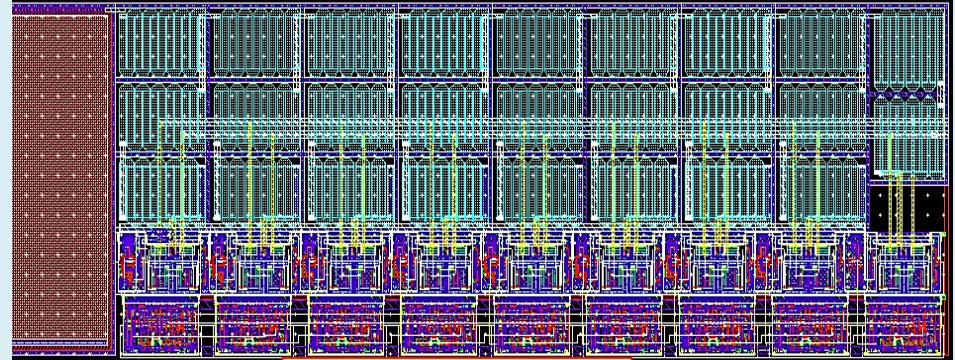
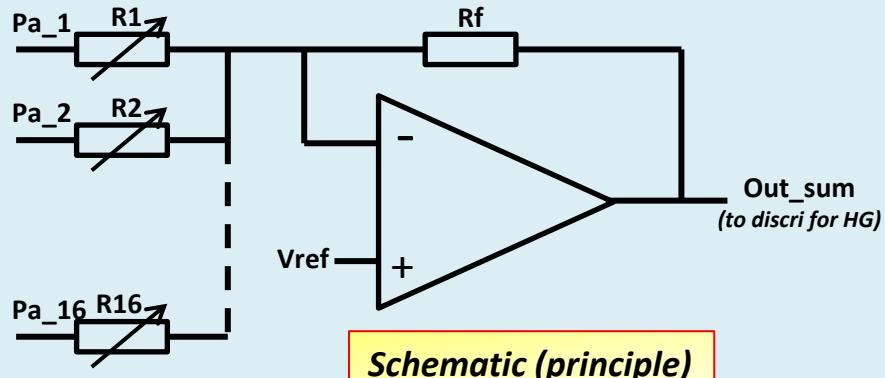
Pré-amplificateur simulation



Pré-amplificateur simulation

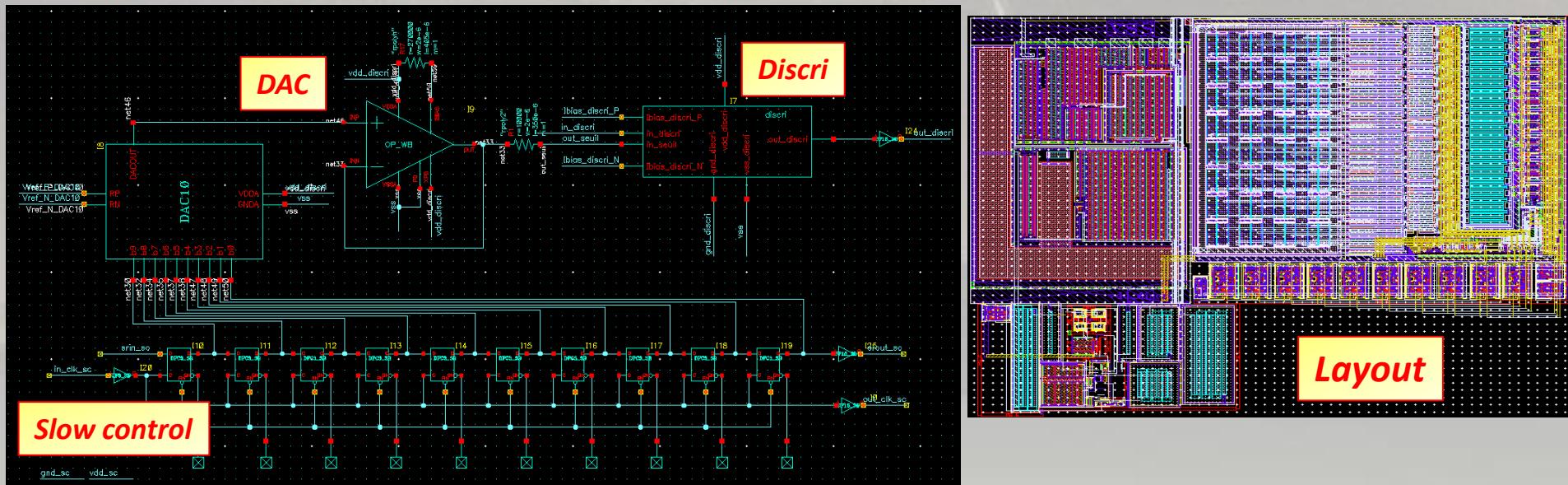


Somme analogique et ajustement des gains



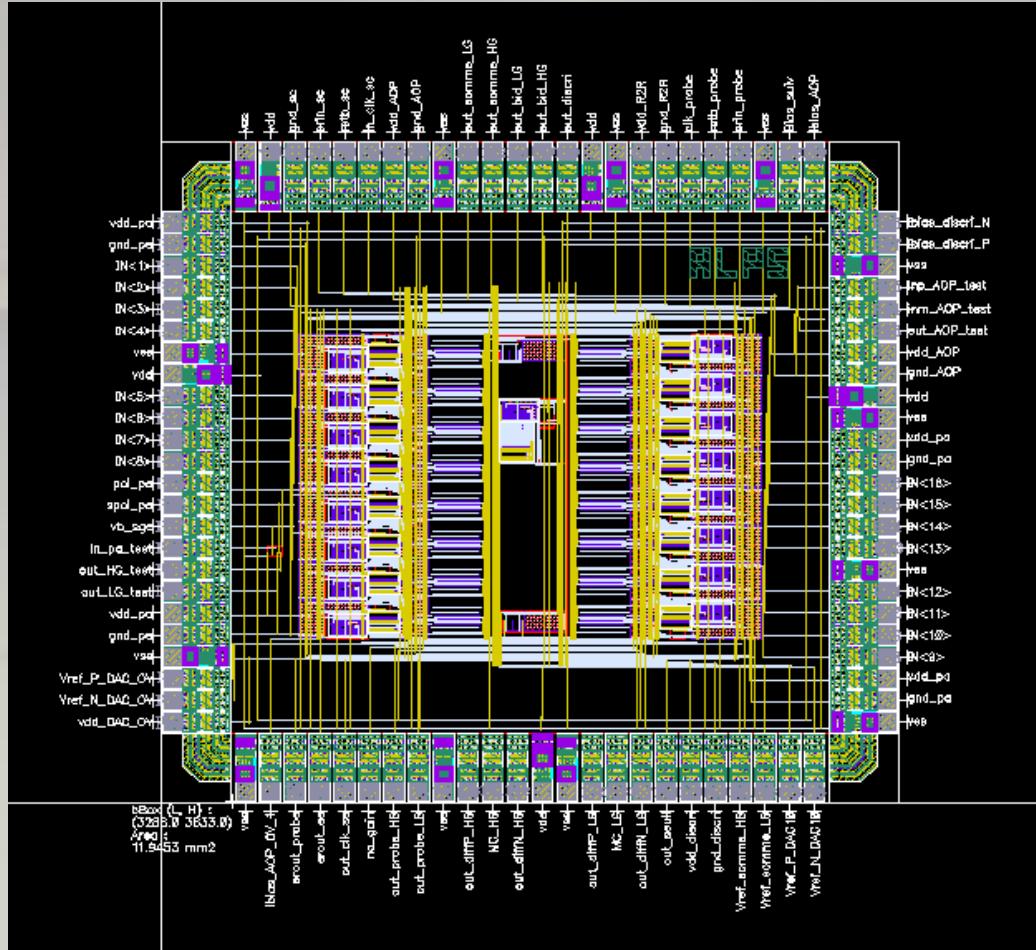
- Somme des 16 sorties de préamp (résistances contrôlées)
- R-2R architecture :
 - Préamp voit toujours la même charge (mieux pour la linéarité)
 - Ajustement des gains – résolution 8 bits
 - Suppression des canaux bruyants
- CR shaping inclus dans chaque canal
- Vref ajustée selon le seuil du discriminateur

Trigger (DAC + discri)



- Discriminator (full custom) :
 - étage entrée (Dual bipolar) => minimiser l'offset
 - Self-biased
 - Buffered digital output for trigger
- DAC (10 bits seuil)
 - AMS standard cell
 - Seuil controlable

ALPS - layout



- AMS BiCMOS 0.35μm
- 96 pin out
- Die size:
about 3.673 X 3.298 mm²
- En fabrication depuis Mars
- Test en juin

Bibliography

- [1]. B.S. Acharya, et al.“Introducing the CTA concept”, Astroparticle Physics 43 (2013) 3-18
- [2]. H. Mathieu, «Physique des semiconducteurs et des composants électroniques »,